

增刊

质子和1MeV中子在硅中能量沉积的模拟计算

陈世彬<sup>1,2</sup>,张义门<sup>1</sup>,陈雨生<sup>2</sup>,黄流兴<sup>2</sup>,张玉明<sup>1</sup>

1 西安电子科技大学微电子所 西安 710071)

(2 西北核技术研究所 西安 710024

收稿日期 2000-3-16 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 在现有中子截面数据和粒子与物质相互作用的理论基础上,编写了计算中子非电离能量损失(NIEL)和电离能量损失(IEL)程序,利用该程序和引进的TRIM95程序计算了1MeV中子和质子在硅中IEL和NIEL的大小和分布等,并对计算结果进行了分析和比较.

关键词 [中子损伤](#) [计算机模拟](#) [蒙特卡罗](#) [能量沉积](#)

分类号

DOI:

### 扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(966KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中包含“中子损伤”的相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [陈世彬](#)